

(12) 特許協力条約に基づいて公開された国際出願

(19) 世界知的所有権機関
国際事務局

(43) 国際公開日
2021年7月29日(29.07.2021)



(10) 国際公開番号

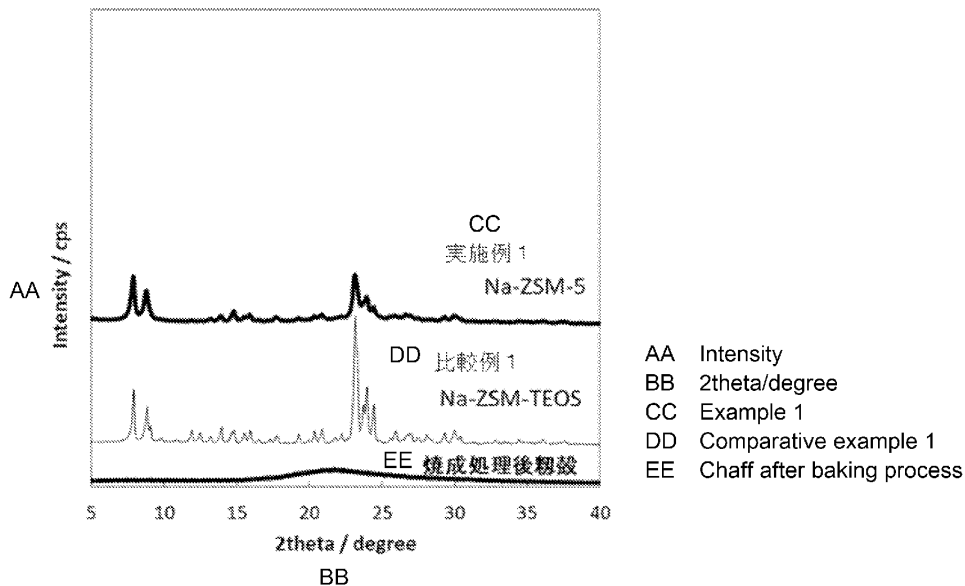
WO 2021/149600 A1

- (51) 国際特許分類:
C01B 39/48 (2006.01) C01B 39/26 (2006.01)
C01B 39/14 (2006.01) C01B 39/38 (2006.01)
- (21) 国際出願番号: PCT/JP2021/001192
- (22) 国際出願日: 2021年1月15日(15.01.2021)
- (25) 国際出願の言語: 日本語
- (26) 国際公開の言語: 日本語
- (30) 優先権データ:
特願 2020-009291 2020年1月23日(23.01.2020) JP
- (71) 出願人: ソニーグループ株式会社(SONY GROUP CORPORATION) [JP/JP]; 〒1080075 東京都港区港南1丁目7番1号 Tokyo (JP).
- (72) 発明者: 田畑 誠一郎 (TABATA Seiichiro); 〒1080075 東京都港区港南1丁目7番1号 ソニー株式会社内 Tokyo (JP). 横井 俊之(YOKOI Toshiyuki); 〒2210804 神奈川県横浜市神奈川区栗田谷6-4 Kanagawa (JP).
- (74) 代理人: 渡邊 薫 (WATANABE Kaoru); 〒1080014 東京都港区芝四丁目10番5号 ヒューリック田町ビル6階 薫風国際特許事務所 Tokyo (JP).
- (81) 指定国(表示のない限り、全ての種類の国内保護が可能): AE, AG, AL, AM, AO, AT, AU, AZ, BA, BB, BG, BH, BN, BR, BW, BY, BZ, CA, CH, CL, CN, CO, CR, CU, CZ, DE, DJ, DK, DM, DO, DZ, EC, EE, EG, ES, FI, GB, GD, GE, GH, GM, GT, HN,

(54) Title: METHOD FOR PRODUCING POROUS MATERIAL, POROUS MATERIAL OBTAINED BY SAID METHOD, AND Si-SOURCE COMPOSITION FOR POROUS MATERIAL PRODUCTION

(54) 発明の名称: 多孔質材料の製造方法、これにより得られる多孔質材料、及び多孔質材料を製造するためのSi源組成物

[図1]



(57) Abstract: Provided is a technique that enables effective utilization of plant-derived Si sources. This technique can provide a method for producing a porous material containing Si and Al, the method using at least a first Si-source composition, which is a plant-derived Si source, and an Al source as raw materials. The first Si-source composition may

[続葉有]

WO 2021/149600 A1

HR, HU, ID, IL, IN, IR, IS, IT, JO, JP, KE, KG, KH,
KN, KP, KR, KW, KZ, LA, LC, LK, LR, LS, LU, LY,
MA, MD, ME, MG, MK, MN, MW, MX, MY, MZ,
NA, NG, NI, NO, NZ, OM, PA, PE, PG, PH, PL, PT,
QA, RO, RS, RU, RW, SA, SC, SD, SE, SG, SK, SL,
ST, SV, SY, TH, TJ, TM, TN, TR, TT, TZ, UA, UG,
US, UZ, VC, VN, WS, ZA, ZM, ZW.

- (84) 指定国(表示のない限り、全ての種類の広域保護が可能): ARIPO (BW, GH, GM, KE, LR, LS, MW, MZ, NA, RW, SD, SL, ST, SZ, TZ, UG, ZM, ZW), ユーラシア (AM, AZ, BY, KG, KZ, RU, TJ, TM), ヨーロッパ (AL, AT, BE, BG, CH, CY, CZ, DE, DK, EE, ES, FI, FR, GB, GR, HR, HU, IE, IS, IT, LT, LU, LV, MC, MK, MT, NL, NO, PL, PT, RO, RS, SE, SI, SK, SM, TR), OAPI (BF, BJ, CF, CG, CI, CM, GA, GN, GQ, GW, KM, ML, MR, NE, SN, TD, TG).

添付公開書類:

- 国際調査報告 (条約第21条(3))

be a Si source that is recovered by a Si recovering process conducted after the plant-derived raw material is subjected to a carbonization process. A second Si-source composition may be a processed substance obtained by subjecting the plant-derived raw material to a decarbonization process.

(57) 要約: 植物由来の Si 源を有効利用できる技術を提供すること。本技術は、植物由来の Si 源である第一 Si 源組成物と、Al 源とを少なくとも原料として用いる、Si 及び Al を含む多孔質材料の製造方法を提供することができる。前記第一 Si 源組成物が、植物由来の原料を炭化処理後に、Si 源を回収する処理を行い、このときに回収された Si 源でもよい。第二 Si 源組成物が、植物由来の原料を脱炭処理して得られた処理物でもよい。